

2015年3月30日

NEDIA 会員様 各位

(一社)日本電子デバイス産業協会
理事 企画委員長
泉谷 涉

第3回 NEDIA アクションセミナー開催のご案内

NEDIA 企画委員会では、会員様向けに、タイムリー、かつ役立つ業界情報を提供し、会員様の価値向上を図るべく、アクションセミナーの開催を企画しました。

第2回に引続き、パワーデバイスに関する企画を継続していく方針で、「第3回 NEDIA アクションセミナー」を下記の開催案内の通り、開催することにしました。ぜひご一読頂き、多くの会員様にご参加頂けることを心よりお待ちしております。

————— 開催案内 —————

1. 開催日時：2015年4月13日(月) 17:00~18:30
2. 開催場所：UTホールディングス株式会社 セミナールーム
住所：東京都品川区東五反田1丁目11番15号 電波ビル4F
マップ <http://www.ut-h.co.jp/corporate/map.html>

3. セミナーテーマ：「SiC パワーデバイスの最新動向とその応用」
<アブストラクト>

SiC パワーデバイスは Si の限界を超える新材料デバイスとして期待されている。2010 年には MOSFET の実用化も始まっており、市場も徐々に広がりつつある。しかし始まったばかりの SiC デバイスは、まだ十分にその実力が発揮できていないわけではなく、今後さらなる進化が期待されている。その一つとして、オン抵抗を数分の 1 に低減できるトレンチ型 MOSFET の実用化が間もなく始まる。トレンチ MOS は性能向上だけではなく、チップ面積縮小による低価格化も期待できる。また、現状では SiC は従来の Si MOS や Si IGBT の置き換え市場が主流であるが、その低オン抵抗、高速性はこれまで Si では実現できなかった分野まで応用できる可能性を秘めている。今回は、デバイスの進化だけでなく SiC ならではの応用についても言及する。

4. 講師：ローム株式会社 研究開発部 部長
博士(工学) 中村 孝 様

5. タイムテーブル：16:30~受付開始
17:00~18:00 セミナー
18:00~質疑応答(終了は18:30 予定)

6. 参加費：NEDIA 会員 1,000 円、非会員 3,000 円
ご参加の申込みは、4月7日(火)までにメールにて事務局までお願い致します。
申込みを確認後、事務局より返信いたします。

定員(約 40 名程)になりましたら、申込みを終了させていただきます。

<事務局連絡先>

E-mail : info@nedia.or.jp TEL : 03-5823-4465 FAX : 03-5823-4475

以上